

圖 11-14 不同介電常數材料之厚度與電容值關係。

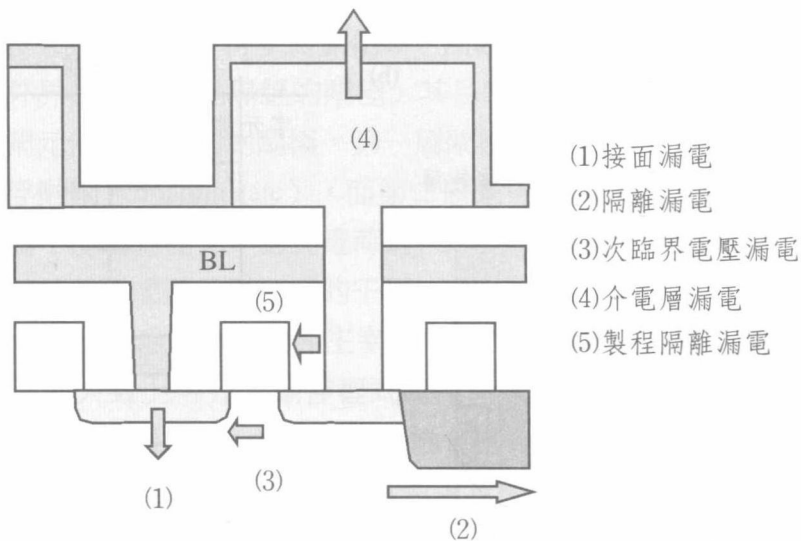


圖 11-15 DRAM 漏電來源。

3. 次臨界電壓漏電 Sub-threshold leakage ($<0.1\text{pA/tr.}$) —— 提高電晶體 V_t ，改善短通道效應來改善元件漏電。